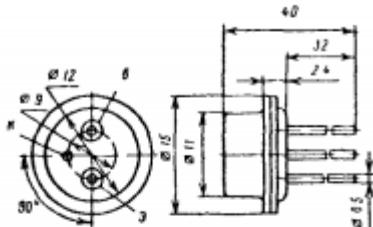


2T602 [A, B], 2T602 [AM, BM], KT602 [AM, BM]

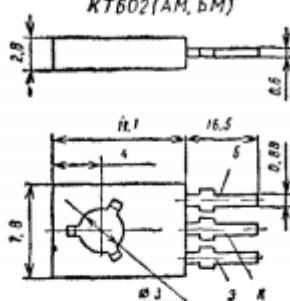
Транзисторы кремниевые планарные структуры *p-n-p*. Предназначены для генерирования и усиления сигналов. Транзисторы 2T602A, 2T602B выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами, 2T602AM, 2T602BM, KT602AM, KT602BM — в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзисторов 2T602A, 2T602B не более 5 г, 2T602AM, 2T602BM, KT602AM, KT602BM — не более 1 г.

2T602 [A, B].



2T602 [AM, BM]
KT602 [AM, BM]



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{CE}=10$ В, $I_B=10$ мА:

2T602A, 2T602AM, KT602AM	20..80
2T602B, 2T602BM	50..200
KT602BM, не менее	50
2T602A, 2T602AM при $T=-60$ °C, KT602AM при $T=-45$ °C	5..80
2T602B, 2T602BM при $T=-60$ °C	12..200
2T602A, 2T602AM при $T=+125$ °C, KT602AM при $T=+85$ °C	50..500

Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{CE}=10$ В, $I_E=25$ мА, не менее

150 МГц

Границочное напряжение при $I_B=50$ мА, не менее

70 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при $I_K=-50$ мА, $I_B=5$ мА, не более

3 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при $I_K=50$ мА, $I_B=5$ мА, не более

3 В

Постоянная времени цепи обратной связи на высокой ча-

стоте при $U_{CE}=10$ В, $I_E=10$ мА, $f=2$ МГц, не более

300 пс

Емкость коллекторного перехода при $U_{CEO}=50$ В, не более

4 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{EBO}=0$, не более

25 пФ

Обратный ток коллектора при $U_{CEO}=120$ В, не более

10 нКА

2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM

70 нКА

Обратный ток коллектор — эмиттер при $U_{CEO}=100$ В, $R_E=10$ Ом, не более:

10 нКА

2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM

100 нКА

KT602AM, KT602BM

50 нКА

Обратный ток эмиттера при $U_{EBO}=5$ В, не более

50 нКА

Пределенные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — база:

2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM

120 В

$T_a = +100$ °C

60 В

KT602AM, KT602BM

120 В

$T_a \leq +70$ °C

120 В

$T_a = +120$ °C

60 В

Импульсное напряжение коллектор — база:

2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM

160 В

$T_a = +100$ °C

160 В

$T_a = +150$ °C

80 В

KT602AM, KT602BM при $T_a = +70$ °C

160 В

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при $R_{es}=1$ кОм:

2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM

100 В

$T_a = +100$ °C

50 В

$T_a = +150$ °C

100 В

KT602AM, KT602BM

100 В

$T_a \leq +70$ °C

50 В

$T_a = +120$ °C

50 В

Постоянное напряжение эмиттер — база

5 В

Постоянный ток коллектора

75 мА

Импульсный ток коллектора при $t_s \leq 1$ мкс

500 мА

Постоянный ток эмиттера

80 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

без теплоотвода:

$T \leq +25$ °C

0.85 Вт

$T = +125$ °C 2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM

0.16 Вт

$T = +85$ °C KT602AM, KT602BM

0.2 Вт

с теплоотводом:

$T \leq +25$ °C

2.8 Вт

$T = +125$ °C 2T602A, 2T602B, 2T602AM, 2T602BM

0.56 Вт

$T = +85$ °C KT602AM, KT602BM

0.65 Вт

Тепловое сопротивление:

переход — корпус

45 °C/Bт

переход — окружающая среда

150 °C/Bт